

National Research Tomsk State University

Возбуждение гигантского дипольного резонанса излучением (110) каналированных электронов в кристалле Si

Н.А. Ашурко¹, О.В. Богданов^{1,2}



¹Tomsk State University, 36 Lenin Ave, 634050 Tomsk, Russia ²Tomsk Polytechnic University, 30 Lenin Ave, 634050 Tomsk, Russia

Введение

- Исследование гигантского дипольного резонанса (ГДР), как коллективное ядерное возбуждение [1], является актуальной областью теоретических и экспериментальных исследований [2].
- Одним из способов возбуждения ГДР является рассеяние гамма фотонов на ядра [3].
- Излучение при каналировании (ИК) электронов в кристаллах обладает высокоэнергичным спектром
 [4] и может представлять интерес в качестве нового метода исследования ГДР в тяжелых ядрах.
- Существует много теоретических и экспериментальных работ, посвященных проблеме получения максимального выхода этого излучения в тонких и толстых кристаллах.
- Излучение при плоскостном каналировании имеет ряд преимуществ по сравнению с другими типами излучения (квазимонохроматичность, фокусировка и т.д.).
- Ранее нами была предложена гибкая схема генерации фотонейтронов легкими ядрами [5], в данной работе мы предлагаем использовать подобную схему для исследования возбуждения ГДР в тяжёлых ядрах.

Цель данной работы — исследовать возбуждение ГДР в средних и тяжёлых ядрах излучением каналированных электронов в кристалле Si.

Модель

Для построения спектров излучения электронов при (110) каналировании в Si применим классический метод БКС [4]. Уравнения движения, моделирование межплоскостного потенциала и обозначения будем использовать здесь, как в [5].

На рисунке ниже представлены межплоскостной усредненный потенциал взаимодействия каналированных релятивистских электронов и соответствующие траектории равные 50 с энергией 1200 МэВ, толщиной кристалла Si 20 мкм и нулевым углов влёта. Толщина кристалла выбрана в пределах длины деканалирования, чтобы избежать процессов многократного рассеяния. Расходимостью в пучке электронов так же пренебрегаем.

Спектры интенсивности излучения (110) каналированных электронов в кристалле Si

Траектории каналированных электронов с различным углом влёта







Плоскости каналирования



С учетом, введенного потенциала (110) Si и соответствующих уравнений движения электронов численно рассчитано усредненное по точкам влета спектрально угловое распределение излучения по формуле ниже. Видно, что спектр состоящий из 300 траекторий электронов с энергией 1200 МэВ, шириной кристалла 20 мкм и нулевым углом влёта имеет квазимонохроматический вид с максимум при 12 МэВ.

$$\frac{d\varepsilon}{d\Omega \, d\omega} = \frac{e^2}{4\pi^2 c} \int_0^\tau \frac{\left[\boldsymbol{n} \left[(\boldsymbol{n} - \boldsymbol{\beta}) \dot{\boldsymbol{\beta}} \right] \right]}{(1 - \boldsymbol{n} \boldsymbol{\beta})^2} e^{i(\omega t - \boldsymbol{k} \boldsymbol{r})} dt$$

Здесь, $\mathbf{k} = \omega \mathbf{n}/c$ и ω – волновой вектор и частота испускаемого излучения, **n** - единичный вектор, определяющий направление излучения фотона, $\mathbf{r}(t) = \mathbf{\beta}_{||}ct + \mathbf{r}_{\perp}(t)$ - траектория электрона; $\mathbf{\beta} = \dot{\mathbf{r}}(t)/c = \mathbf{\vec{\beta}}_{||} + \mathbf{\vec{\beta}}_{\perp}$ - скорость, причем $\mathbf{\vec{\beta}}_{||} = \mathbf{\vec{\nu}}_{||}/c$, $\mathbf{\vec{\beta}}_{\perp} = \mathbf{\vec{\nu}}_{\perp}/c$ и $\mathbf{\vec{\beta}}_{||} = \mathbf{\vec{\nu}}_{||}/c$ =const - составляющая скорости, параллельная плоскостям кристалла.

Уравнение движения в поперечном направлении

$$\gamma m \ddot{x} = F = -\frac{\partial U(x)}{\partial x}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_{\parallel}^2}{c^2}}}$$

Данные ГДР для Au, Pb, U представлены в таблице 1. На рисунке 2 представлены поперечные сечения ГДР на ядрах и . Нетрудно заметить, что основные параметры, такие как положения и ширины пиков для спектра излучения электронов с энергией 1200 МэВ на рис. 2 и сечений











Спектр тормозного излучения электронов в

аморфном Si

Поперечные сечения ГДР на ядрах Аи, Pb и U

Отношения выходов ГДР ИК к тормозному излучению для различных мишеней





Поперечные сечения ГДР на ядрах Zn



Заключение

ГДР на рис. 2 близки.

Ядро	Максимальная энергия (МэВ)	Максимальное поперечное сечение (тбарн)	Полная ширина на половине максимума
Au	13.2	515.8	4.2
Pb	13.5	572	4.3
U	11.44	300.3	3.2

- Траектории были получены путем численного решения уравнений движения с использованием компьютерного кода "Basic Channeling with Mathematica©" BCM-2.0.
- Параметры расчетов: Толщина кристалла L=20 мкм, энергией 1200 МэВ, угол влета равен нулю, где θ_c – критический угол каналирования.

Полный выход реакции ГДР будем рассчитать следующим образом

$$Y(\gamma_e) = \int_{c}^{c_2} d\hbar\omega \cdot N_{CR}(\gamma_e, \hbar\omega) \cdot [\sigma_{GDR}(\hbar\omega)], \qquad N_{CR}(\gamma_e, \hbar\omega) = \frac{1}{\hbar\omega} \cdot \frac{dW}{d\hbar\omega \, dz}$$

где $N_{CR}(\gamma_e, \hbar\omega)$ - число фотонов ИК, ε_1 и ε_2 - характерные энергии ГДР, $\sigma_{GDR}(\hbar\omega)$ - поперечное сечение вблизи ГДР. Значение $Y(\gamma_e)$ зависит от релятивистского фактора γ_e каналированных первичных электронов, которые испускают фотоны ИК в кристалле.

- Численными расчетами исследовано возбуждение ГДР в тяжелых ядрах Аu излучением каналированных электронов в кристалле Si (110). Представлены результаты моделирования отношения полных выходов ГДР ИК к тормозному излучению (в аморфной мишени Si) для ядра Au с нулевым углом падения электронного пучка относительно (110) кристалла Si плоскости в зависимости от релятивистского фактора электронов. Видно, что это отношение увеличивается в зависимости от энергии электронов и имеет ярко выраженный максимум.
- Аналогичные численные исследования представлены для возбуждения ГДР изотопов ³⁰/₆₅Zn, ³⁰/₆₆Zn, ³⁰/₆₇Zn, ³⁰/₆₈Zn. Показано, что исследования ГДР предлагаемым методом может быть эффективно для ядер умеренной массы.

Литература

- Migdal A. B. Quadrupole and dipole -radiation of nuclei // Phys. J. Phys (USSR). 1944.-Vol.8. P. 331
- 2. Wang R. et al. Constraining the in-medium nucleon-nucleon cross section from the width of nuclear giant dipole resonance // Physics Letters B. 2020. Vol. 807. P. 14-19
- Baldwin G.C., Klaiber G.S. Photo-Fission in heavy elements // Phys. Rev. 1947. Vol. 71. P. 3–10
- 4. Байер В.Н., Катков В.М., Страховенко В.М. Электромагнитные процессы при высокой энергии в ориентированных монокристаллах. М.: Наука, 1989. С. 400
- 5. Bogdanov O.V., Dabagov S.B., Pivovarov Yu. L. Photonuclear reactions by relativistic electrion channeling radiation // NIM B.- 2020. Vol.465. P. 67-72
- 6. Varlamov V.V. Center for Photonuclear Experiments Data [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cdfe.sinp.msu.ru. (дата обращения: 15.03.2023)

52-я Международная Тулиновская конференция по Физике Взаимодействия Заряженных Частиц с Кристаллами, 30 мая — 1 июня 2023 г. МГУ, Москва